

Germanium PNP Transistor

OD603

40V / 3A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1961

OD 603**pnp-
Flächentransistor****Leistungsstufen, $P_{C+E} = 4 \text{ W}$** **Gleichstrom-Meßwerte, $t_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$** **1. Arbeitspunkt** $-U_{CE} = 7 \text{ V}$, $-I_C = 60 \text{ mA}$

Basisspannung	$-U_{BE}$	270	mV
---------------	-----------	-----	----

2. Arbeitspunkt $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 200 \text{ mA}$

Basisstrom	$-I_B$	3	mA
------------	--------	---	----

Basisspannung	$-U_{BE}$	370	mV
---------------	-----------	-----	----

3. Arbeitspunkt $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 1400 \text{ mA}$

Basisstrom	$-I_B$	55 < 90	mA
------------	--------	---------	----

Basisspannung	$-U_{BE}$	850 < 1100	mV
---------------	-----------	------------	----

Restströme

Collectorreststrom, $-U_{CB} = 6 \text{ V}$ Emitter offen	$-I_{cbo}$	10 < 25	μA
--	------------	---------	---------------

Collectorreststrom, $-U_{Ck} = 6 \text{ V}$ Emitter-Basis kurzgeschlossen	$-I_{ck}$	30 < 80	μA
--	-----------	---------	---------------

Collectorreststrom, $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ Basis offen	$-I_{ceo}$	350 < 1000	μA
--	------------	------------	---------------

Wärme-Innenwiderstand

$R_{i \text{ therm}}$	$\leq 7,5$	$^\circ\text{C/W}$
-----------------------	------------	--------------------

Bedingungen für paarweise Lieferung**Statische Werte**Arbeitspunkt: $-I_C = 1400 \text{ mA}$, $-U_{CE} = 1 \text{ V}$

Unterschiede zwischen beiden Transistoren:

Spannung Basis-Emitter	ΔU_{BE}	< 50	mV
------------------------	-----------------	------	----

Stromverstärkungsfaktor = $B = \frac{-I_C}{-I_B}$	ΔB	< + 20	%
---	------------	--------	---

Arbeitspunkt: $-I_C = 60 \text{ mA}$, $-U_{CE} = 7 \text{ V}$

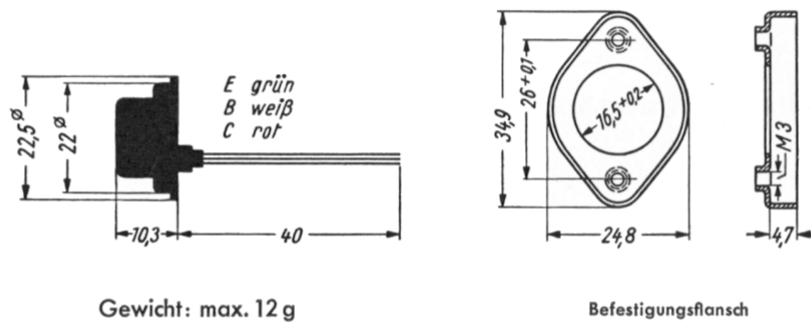
Unterschied zwischen beiden Transistoren:

ΔU_{BE}	< 15	mV
-----------------	------	----

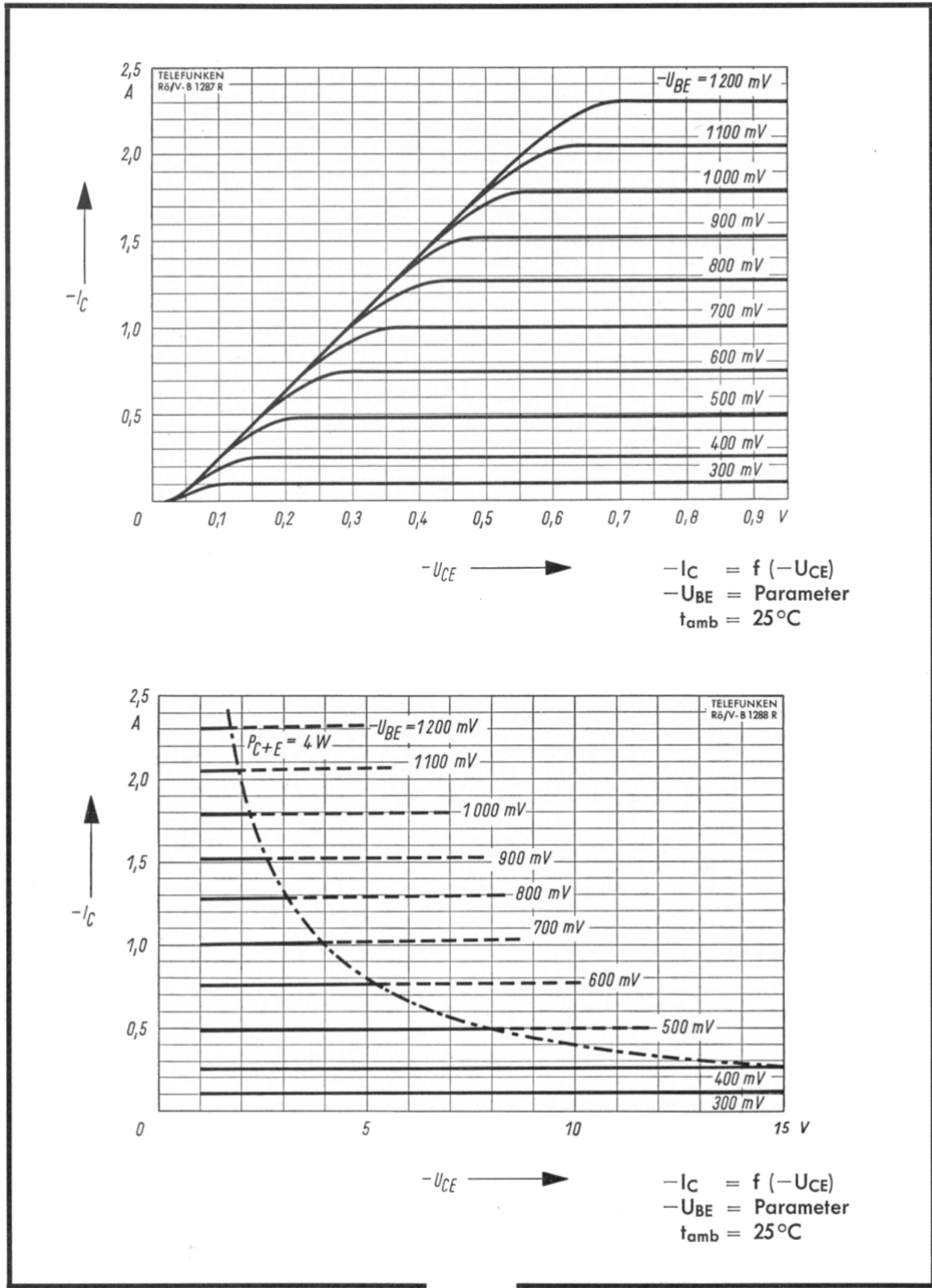
OD 603**Grenzwerte, absolute Maxima**

Spannung zwischen Collector und Emitter bei offener Basis	$-U_{CEo}$	30	V
Spannung zwischen Collector und Emitter bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke	$-U_{Ck}$	40	V
Spannung zwischen Collector und Basis bei offenem Emitter	$-U_{CBo}$	40	V
Spannung zwischen Emitter und Basis bei offenem Collector	$-U_{EBo}$	10	V
Collectorspitzenstrom, Impulsbreite < 1 ms, Impulsfolge 45 Hz	$-I_C$	3	A
Collector- + Emitter-Verlustleistung, $t_{Gehäuse} = 45^\circ\text{C}$	P_{C+E}	4	W
Sperrschichttemperatur	t_j	75	$^\circ\text{C}$

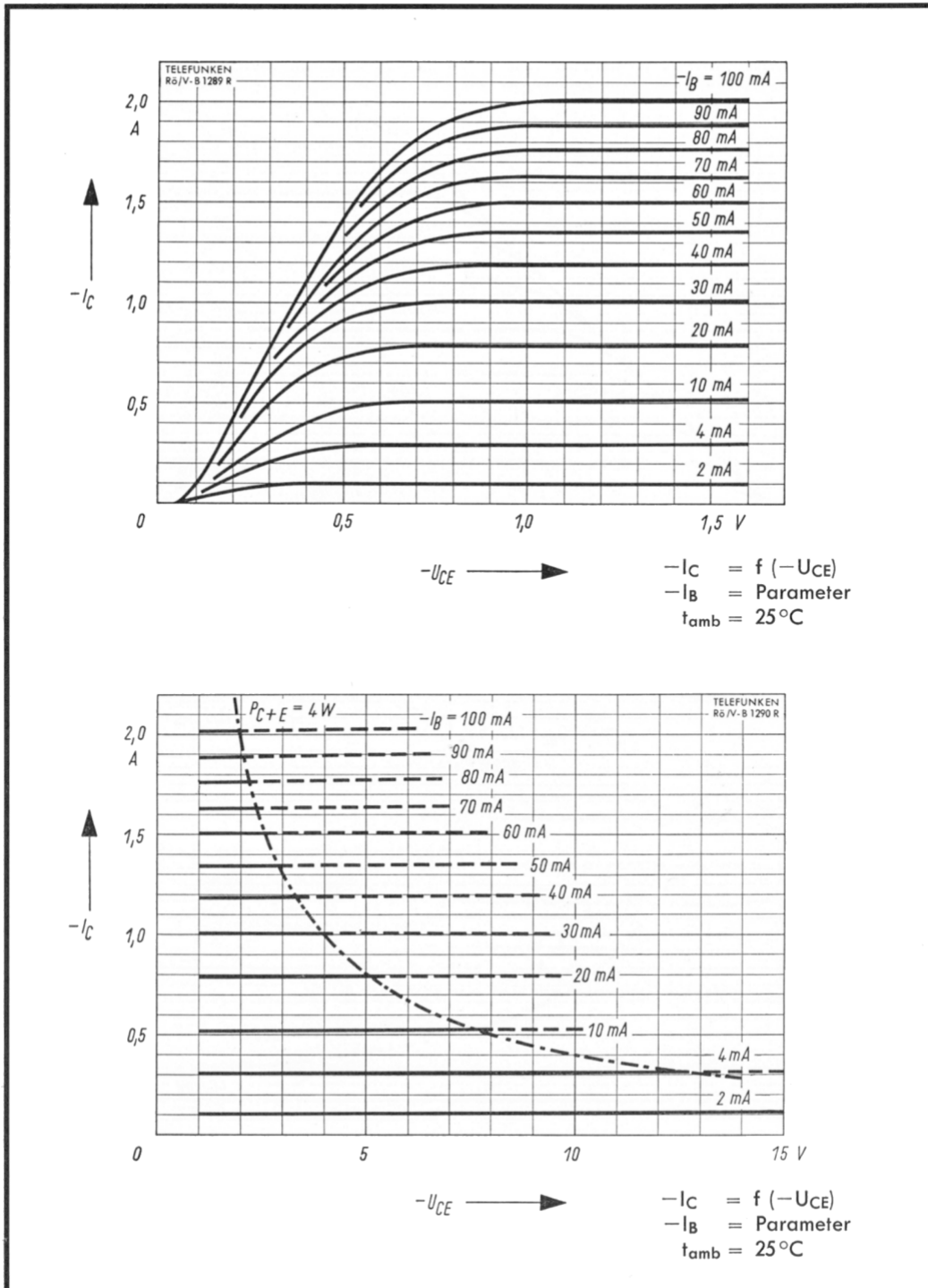
max. Abmessungen



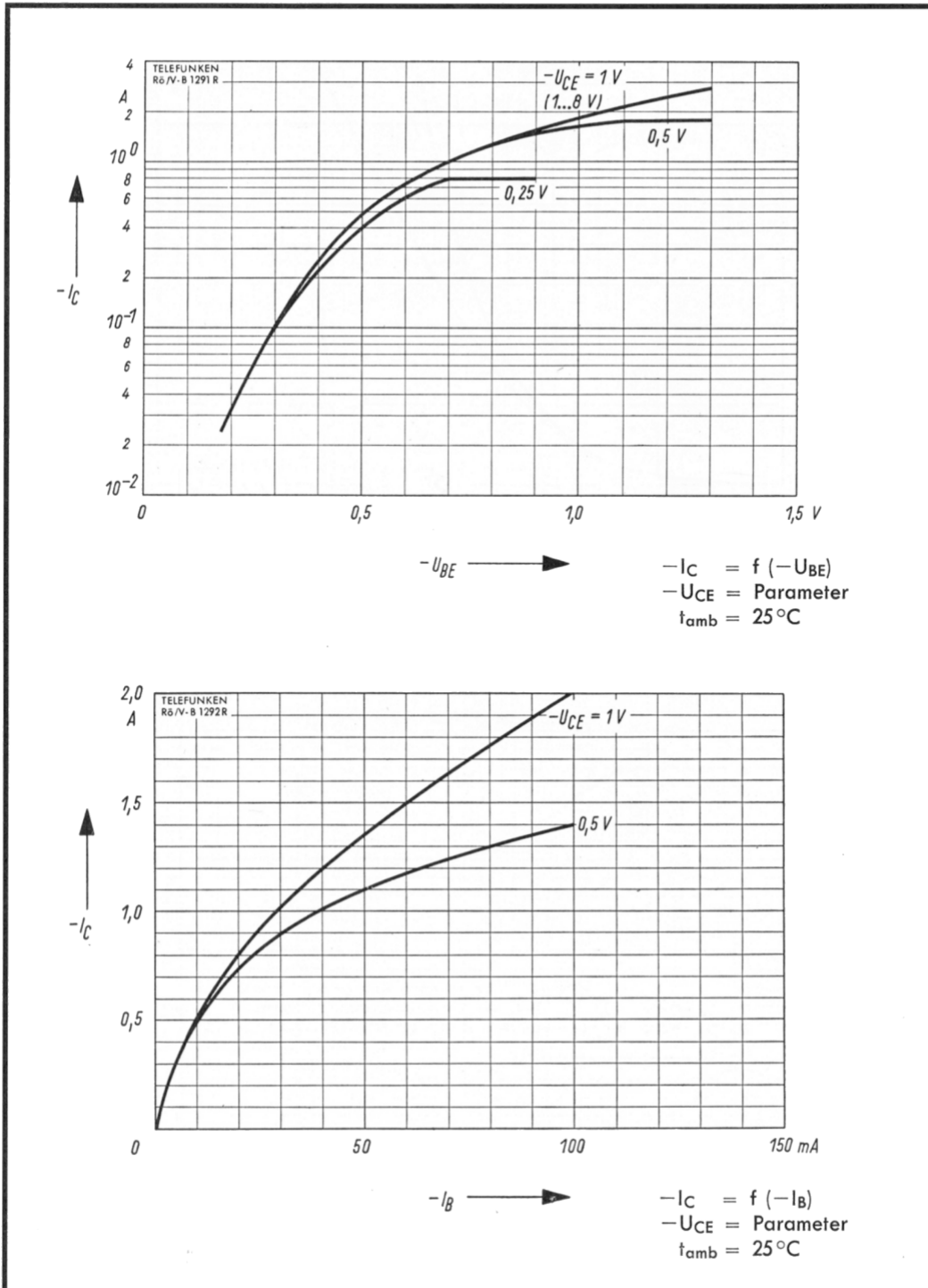
OD 603



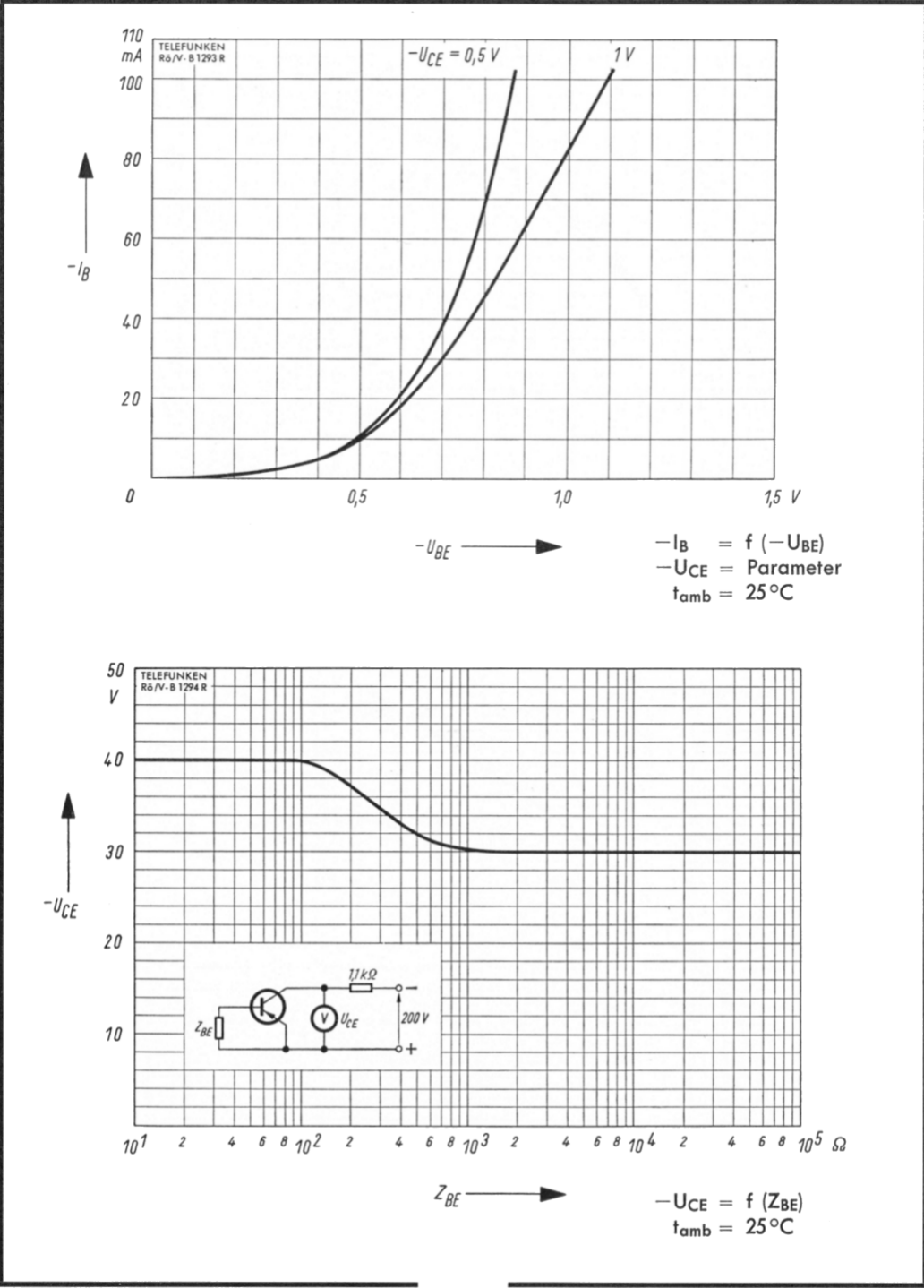
OD 603



OD 603



OD 603



OD 603

